

Tesi di laurea disponibile presso il CNR-IMM di Catania

E' disponibile un argomento di tesi sperimentale per studenti dei corsi di laurea specialistica in Fisica o Ingegneria Elettronica, da svolgersi presso l'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania – CNR-IMM (<https://hq.imm.cnr.it>).



Il lavoro di tesi potrà iniziare già da Aprile 2019, avrà la durata di 3-6 mesi, e verterà sul tema:

“Caratterizzazione di strati di ossido di gallio (Ga_2O_3) per dispositivi elettronici”

L'ossido di gallio (Ga_2O_3) è un semiconduttore ad ampia gap dalle interessanti proprietà fisiche ed elettroniche, che lo rendono un ottimo candidato per la realizzazione di dispositivi elettronici dalle prestazioni superiori a quelle del silicio. Nell'ambito del lavoro di tesi, dopo avere effettuato una ricerca bibliografica sul materiale, il candidato verrà guidato allo svolgimento di analisi di tipo morfologico, strutturale ed elettrico su campioni di Ga_2O_3 commerciali. Nel corso del lavoro, si prevede anche la realizzazione di semplici prototipi di dispositivi elettronici (es. diodi, condensatori, etc.) presso la camera bianca del CNR-IMM di Catania e la loro caratterizzazione elettrica.

Gli interessati possono contattare via email:

Dott. Fabrizio Roccaforte (fabrizio.roccaforte@imm.cnr.it)

Dott. Filippo Giannazzo (filippo.giannazzo@imm.cnr.it)